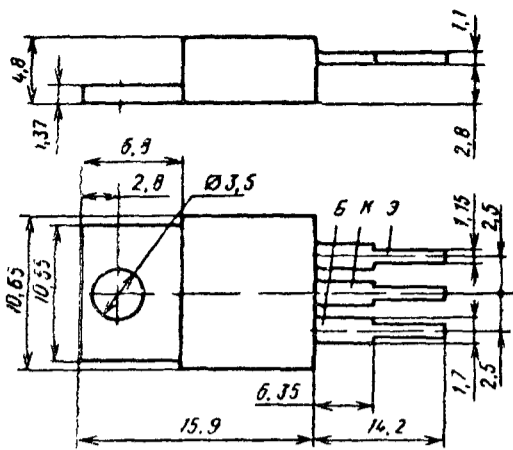


2Т883 (А, Б)

2Т883 (А, Б)



Транзисторы кремниевые планарные структуры *p-n-p* переключаательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами

Масса транзистора не более 2,5 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_Э=0,5$ А, не менее:

$T=+25$ °С	25
$T=+100$ °С	18
$T=-60$ °С	10

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_Э=50$ мА, не менее 20 МГц

Граничное напряжение при $I_К=20$ мА, не менее:	
2Т883А	250 В
2Т883Б	200 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_К=0,5$ А, $I_Б=0,1$ А, не более 1,8 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_К=0,5$ А, $I_Б=0,1$ А, не более 1,8 В

Время включения при $U_{КЭ}=40$ В, $I_К=0,2$ А, $I_Б=0,02$ А, не более	0,4* мкс
типичное значение	0,25* мкс

Время выключения при $U_{КЭ}=40$ В, $I_К=0,2$ А, $I_Б=0,02$ А, не более	5,7* мкс
типичное значение	3,3* мкс

Время рассасывания при $U_{КЭ}=40$ В, $I_К=0,2$ А, $I_Б=0,02$ А, не более	5,2* мкс
типичное значение	2,8* мкс

Обратный ток коллектора, не более:

при $T=-60$. +25 °С:	
$U_{КБ}=300$ В для 2Т883А	0,1 мА
$U_{КБ}=250$ В для 2Т883Б	0,1 мА

при $T=+100$ °С:	
$U_{КБ}=250$ В для 2Т883А	0,5 мА
$U_{КБ}=200$ В для 2Т883Б	0,1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=5$ В, не более 0,1 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}=5$ В, не более 70* пФ

 типичное значение 45* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ}=0,5$ В, не более 650* пФ

 типичное значение 450* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база при $dU_{КБ}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т883А	300 В
2Т883Б	250 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сб} \leq 100$ Ом, $dU_{КЭ}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т883А	300 В
2Т883Б	250 В

Постоянное напряжение база — эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 1 А

Импульсный ток коллектора 2 А

Постоянный ток базы 0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора,¹ при $T_к = -60$. +25 °С:

 с теплоотводом 10 Вт

 без теплоотвода 1 Вт

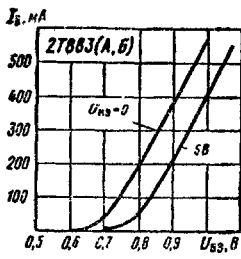
Температура *p-n* перехода +150 °С

Температура окружающей среды -60 °С, $T_к = +100$ °С

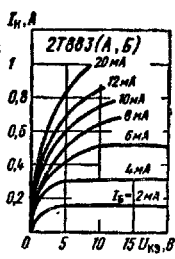
¹ При $T_к = +25$. +100 °С $P_{К, макс}$ снижается линейно на 0,08 Вт/°С с теплоотводом и на 8 мВт/°С без теплоотвода

Допускаются обрезка выводов транзисторов не ближе 6 мм от корпуса и одноразовый изгиб выводов на угол не более 90° от первоначального положения в плоскости, перпендикулярной основанию корпуса, и не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилия на корпус.

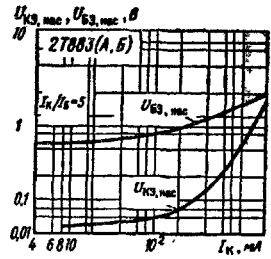
Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 5 мм. При одновременной пайке теплоотводящей поверхности и выводов транзистора пайку осуществлять припоем с температурой не более +260 °С, время пайки не более 3 с; при отдельной пайке теплоотводящей поверхности и выводов транзистора пайку осуществлять припоем с температурой не более +240 °С, общее время пайки не более 8 с. При этом необходимо применение теплоотвода.



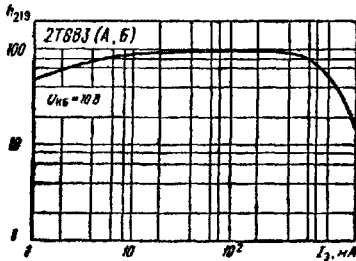
Входные характеристики



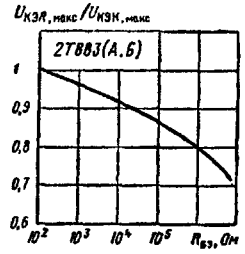
Выходные характеристики



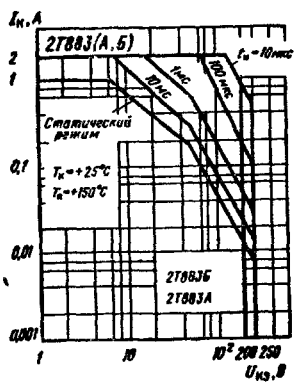
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



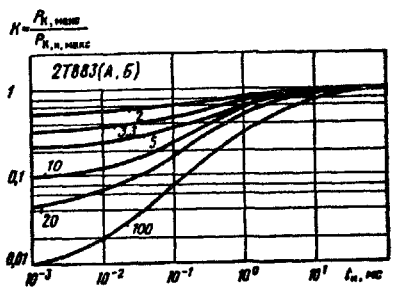
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Области максимальных режимов



Зависимость коэффициента K от длительности импульса